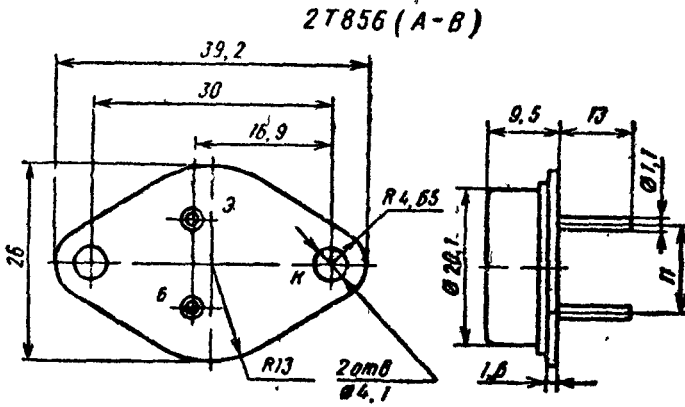


# 2Т856 (А, Б, В)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* переключательные. Предназначены для применения в переключающих устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Масса транзистора не более 16 г



## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КЭ} = 5$  В,  $I_K = 5$  А:

$T_K = +25^\circ\text{C}$ :	
2Т856А	10...30
2Т856Б, 2Т856В	10...60
$T_K = +125^\circ\text{C}$ :	
2Т856А	5...30
2Т856Б, 2Т856В	5...60
$T_K = -60^\circ\text{C}$ :	
2Т856А	5...60
2Т856Б, 2Т856В	5...100

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КЭ} = 10$  В,  $I_K = 2$  А, не менее типовое значение

Граничное напряжение при  $I_K = 0,1$  А, не менее:

$T_K = +25$ и $-60^\circ\text{C}$ :	
2Т856А	450 В
2Т856Б	400 В
2Т856В	300 В
$T_K = +125^\circ\text{C}$ :	
2Т856А	400 В
2Т856Б	350 В
2Т856В	250 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при  $I_K = 5$  А,  $I_B = 1$  А

Напряжение насыщения база — эмиттер при  $I_K = 5$  А,  $I_B = 1$  А

Время включения при  $U_K = 200$  В,  $I_K = 5$  А,  $I_B = 0,5$  А

Время спада при  $U_K = 200$  В,  $I_K = 5$  А,  $I_B = 0,5$  А, не более

Время рассасывания при  $U_K = 200$  В,  $I_K = 5$  А,  $I_B = 0,5$  А, не более

Обратный ток коллектора, не более:

$T_K = +25^\circ\text{C}$ , $U_{КБ} = U_{КБ, макс}$	3 мА
$T_K = +75$ + $125^\circ\text{C}$ и $-40$ ... $-60^\circ\text{C}$ , $U_{КБ} = 800$ В для 2Т856А, 650 В для 2Т856Б, 500 В для 2Т856В	5 мА

Обратный ток эмиттера при  $U_{ЭБ} = 5$  В, не более

Емкость коллекторного перехода при  $U_{КБ} = 90$  В,  $f = 0,3$ ...  $1$  МГц, не более

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база<sup>1</sup> при  $T_K = -40$ ...  $+75^\circ\text{C}$ :

2Т856А	1000 В
2Т856Б	800 В
2Т856В	600 В

Постоянное и импульсное<sup>2</sup> напряжение коллектор — эмиттер при  $R_{ЭЭ} = 10$  Ом:

2Т856А	950 В
2Т856Б	750 В
2Т856В	550 В

Постоянное напряжение эмиттер — база

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора

Постоянный ток базы

Постоянная рассеиваемая мощность<sup>3</sup> при  $U_{КЭ} \leq 40$  В:

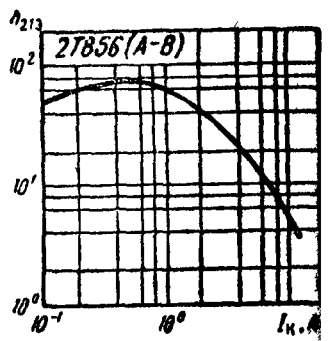
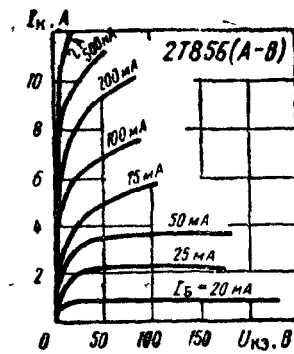
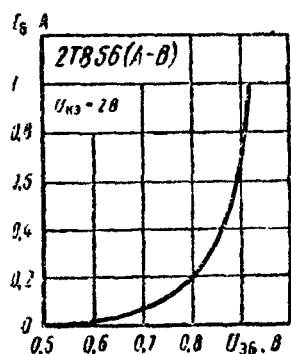
$T_K = +25^\circ\text{C}$	75 Вт
$T_K = +125^\circ\text{C}$	15 Вт
Тепловое сопротивление переход — корпус	1,67 $^\circ\text{C}/\text{Вт}$
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 $^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	-60 $^\circ\text{C}$ ... $T_K = +125^\circ\text{C}$

<sup>1</sup> При  $T_K = -40$ ...  $-60^\circ\text{C}$  и  $T_K = +75$ ...  $+125^\circ\text{C}$   $U_{КБ, макс}$  снижается линейно до 800 В для 2Т856А, 650 В для 2Т856Б, 500 В для 2Т856В.

<sup>2</sup> Для одиночного импульса при  $t_{\phi} > 1$  мкс. При  $t_{\phi} \leq 1$  мкс

$$U_{КЭВ} \text{ и макс} = U_{КЭЭ, гр}$$

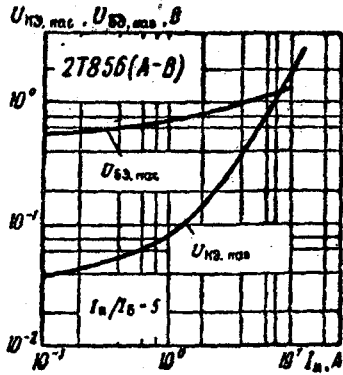
<sup>3</sup> При  $T_K = +25$  +  $125^\circ\text{C}$   $P_{К, макс}$  уменьшается линейно.



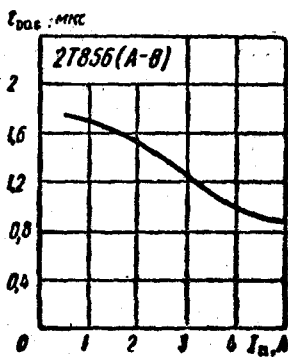
Входная характеристика

Выходные характеристики

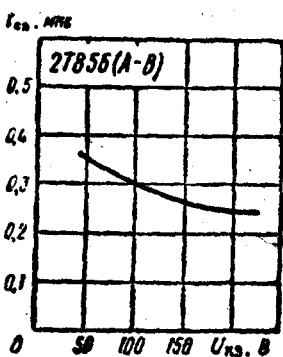
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



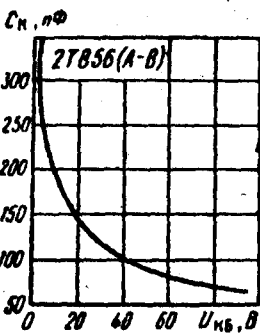
Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока коллектора



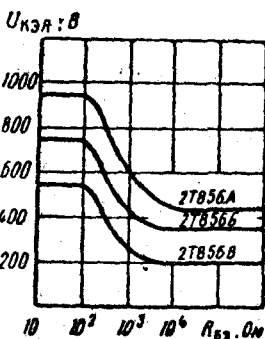
Зависимость времени рассеивания от тока коллектора



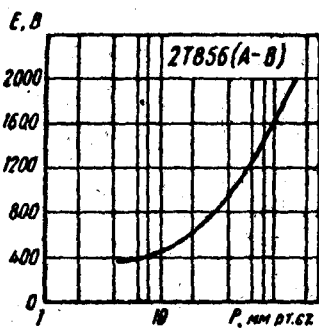
Зависимость времени спада от напряжения коллектор — эмиттер



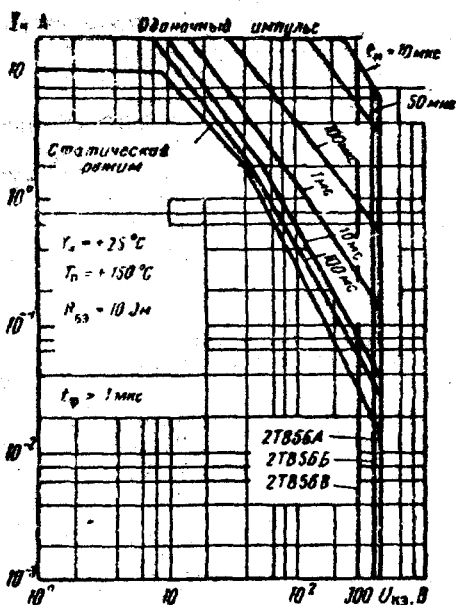
Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор — база



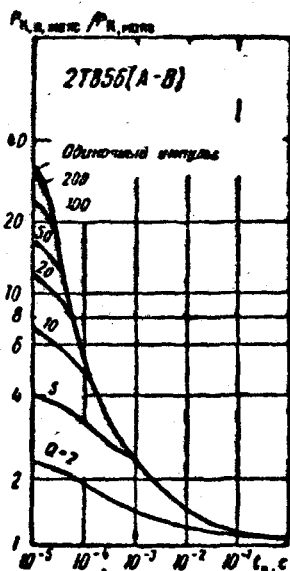
Зависимости постоянно напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



Зависимость электрической прочности воздушных промежутков между выводами базы и коллектора



Области максимальных режимов



Зависимости максимально допустимой импульсной рассеиваемой мощности коллектора от длительности импульса